

A. 有關本集團的進一步資料

1. 本公司註冊成立

本公司於2019年9月17日在中國成立為有限公司，並於2025年6月25日根據中國法律改制為股份有限公司。

截至本文件日期，本公司註冊地址位於中國浙江省杭州市濱江區西興街道聯慧街6號1-608。本公司已在香港設立主要營業地點，地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓，並已於2025年6月30日根據《公司條例》第16部註冊為非香港公司並辦理備案。本公司的公司秘書黃俊穎先生已獲委任為本公司在香港接收法律文件的授權代表，其通訊地址為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2座31樓。

由於本公司在中國成立，本公司的公司架構及組織章程細則受中國相關法律法規規管。我們組織章程細則相關條文的概要載於「附錄五－公司章程概要」。中國法律法規的若干相關方面的概要載於「附錄四－主要法律及監管條文概要」。

2. 本公司股本變動

截至本公司成立為股份有限公司之日，我們的註冊資本為人民幣50,000,000元，分為50,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。我們亦預期於緊接[編纂]前進行[編纂]，據此，我們已發行股本中的每股股份將[編纂]為[編纂]股份。緊隨[編纂]後及[編纂]前，本公司的註冊股本將為人民幣[編纂]元，包含[編纂]股每股面值人民幣0.10元的股份。

於[編纂]完成及[編纂]股份轉換為[編纂]後，經計及[編纂]並假設[編纂]未獲行使及自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動，本公司註冊資本將增至約人民幣[編纂]元，包括[編纂]股每股人民幣[編纂]元的[編纂]股份及[編纂]股每股人民幣[編纂]元的H股，分別佔我們註冊資本的約[編纂]%及[編纂]%

除「歷史、發展及公司架構」一節及上文所披露者外，本公司股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

3. 股東決議案

根據本公司日期為2025年6月26日的股東決議案，股東通過以下決議案（其中包括）：

- (a) 按[編纂]的基準[編纂]每股面值人民幣1.0元的股份，於緊接[編纂]前生效，並計及[編纂]，本公司發行每股面值人民幣[編纂]元的H股，有關H股於聯交所[編纂]；
- (b) 於[編纂]獲行使前發行的H股數目不得超過[編纂]完成後本公司經擴大股本的20%，並向[編纂]授出不超過上述擬發行H股數目[編纂]%的[編纂]；
- (c) 待中國證監會批准後，於[編纂]完成後，若干現有股東持有的[編纂]股[編纂]將轉換為H股；
- (d) 授權董事會及其授權人士處理與[編纂]、H股發行及[編纂]等有關的所有事宜；及
- (e) 待[編纂]完成後，有條件採納組織章程細則，有關細則將於[編纂]生效，且董事會已獲授權根據相關法律法規以及應聯交所及相關中國監管部門要求修訂組織章程細則。

4. 本公司附屬公司及附屬公司股本變動

我們的附屬公司名單載於會計師報告內，有關文本載於本文件附錄一。

除「歷史、發展及公司架構」一節所披露者外，我們附屬公司的股本於緊接本文件日期前兩年內並無變動。

5. 股份購回限制

詳情請參閱本文件「附錄四 — 主要法律及監管條文概要 — 股份回購」一節。

B. 有關我們業務的進一步資料

1. 重大合同概要

以下合同（並非在日常業務過程中訂立的合同）由我們或我們的任何附屬公司於本文件日期前兩年內訂立且屬重大或可能屬重大：

- (a) (1)本公司與(2)瓦森納科技香港有限公司、(3)杭州喜達芯企業管理合夥企業（有限合夥）、(4)杭州喜杭芯企業管理合夥企業（有限合夥）、(5)杭州模芯企業管理合夥企業（有限合夥）、(6)智富有限合夥企業、(7)智益有限合夥企業、(8)杭州海邦啟悅股權投資合夥企業（有限合夥）、(9)智晶國際投資有限公司、(10)珠海巍恒股權投資合夥企業（有限合夥）、(11) HSG Growth VI Holdco B (HK) Limited（前稱SCC GROWTH VI HOLDCO B (HK) LIMITED）、(12)北京君聯晟源股權投資合夥企業（有限合夥）、(13)珠海君聯星澤股權投資企業（有限合夥）、(14)海風投資有限公司、(15)杭州芯盛微股權投資合夥企業（有限合夥）、(16)合肥華芯科瑞集成電路投資合夥企業（有限合夥）、(17)合肥華登二期集成電路產業投資合夥企業（有限合夥）、(18) Cosmic Warrior (HK) Limited、(19)湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）、(20)寧德時代新能源科技股份有限公司、(21) Huh Youm、(22)國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司、(23)杭州芯成微股權投資合夥企業（有限合夥）、(24)杭州芯宇微股權投資合夥企業（有限合夥）、(25)廣州廣祺欣邁管理諮詢合夥企業（有限合夥）、(26)珠海市紅土湛盧股權投資合夥企業（有限合夥）、(27)嘉興恒隼邦股權投資合夥企業（有限合夥）、(28)杭州富陽項恒股權投資合夥企業（有限合夥）、(29)蘇州華業致遠三號股權投資合夥企業（有限合夥）、(30)嘉興泰芯科啟創業投資合夥企業（有限合夥）、(31)杭州星成聯芯創業投資合夥企業（有限合夥）、(32)杭州寓




鑫創業投資合夥企業(有限合夥)、(33)宜賓綠能股權投資合夥企業(有限合夥)、(34)廣東長拓石創業投資合夥企業(有限合夥)、(35)杭州芯嵐微創業投資合夥企業(有限合夥)、(36)珠海君聯星馳創業投資企業(有限合夥)、(37)杭州華芯雲邁股權投資合夥企業(有限合夥)、(38)宜賓晨道新能源產業股權投資合夥企業(有限合夥)、(39)浙江金控投資有限公司(現稱為浙江省創新資本投資有限公司)、(40)杭州海邦睿柏股權投資合夥企業(有限合夥)、(41)寧波海邦星材創業投資合夥企業(有限合夥)及(42)青島精確芯陽科技中心(有限合夥)所訂立的日期為2025年6月24日的有關終止特殊權利之補充協議；及

(b) [編纂]。

2. 我們的知識產權







(a) 商標

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	屆滿日期	註冊地
1.....	芯迈半导体	本公司	60797136	42	2032年5月13日	中國
2.....	芯迈	本公司	60774956	42	2032年5月13日	中國
3.....		本公司	65306186	42	2032年11月27日	中國
4.....		本公司	65310406	9	2032年11月27日	中國
5.....		本公司	65322753	9	2032年11月27日	中國
6.....		本公司	65305779	42	2032年11月27日	中國
7.....	芯迈	本公司	64924102	9	2033年3月27日	中國
8.....	芯迈半导体	本公司	60770749	9	2033年4月6日	中國
9.....	芯迈半导体	本公司	67210495	9	2033年6月13日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	屆滿日期	註冊地
10.....		本公司	68938697	40	2033年7月6日	中國
11.....		本公司	68941046	40	2033年7月6日	中國
12.....	芯迈半导体	本公司	68936312	40	2033年7月20日	中國
13.....	芯迈	本公司	68941029	40	2033年7月6日	中國
14.....	SILICON MAGIC	本公司	72569224	9	2034年12月13日	中國
15.....	MAGICFAST	本公司	77185704	9	2034年8月20日	中國
16.....	HPD PACK	本公司	81287459	9	2035年4月19日	中國
17.....	Silicon Magic	本公司	305895659	9、42	2032年3月2日	香港
18.....	^A 芯迈 ^B 芯邁	本公司	305895631	9、42	2032年3月2日	香港
19.....	^A 芯迈半导体 ^B 芯邁半導體	本公司	305895640	9、42	2032年3月2日	香港
20.....		本公司	306901605	9、42	2035年3月15日	香港
21.....		本公司	306901614	9、42	2035年3月15日	香港
22.....	芯邁半導體	本公司	02237384	42	2032年7月15日	台灣
23.....	芯邁半導體	本公司	02235288	9	2032年7月15日	台灣
24.....	芯迈	本公司	02237383	42	2032年7月15日	台灣
25.....	芯迈	本公司	02235287	9	2032年7月15日	台灣
26.....	Silicon Magic	本公司	02237382	42	2032年7月15日	台灣
27.....	Silicon Magic	本公司	02235286	9	2032年7月15日	台灣
28.....	Silicon Magic	本公司	40-2123534	9、42	2033年12月5日	韓國
29.....	SILICON MAGIC	本公司	7,930,964	9、42	2035年9月1日	美國
30.....	SILICON TOP	杭州芯通	79256579	9	2034年12月6日	中國
31.....		杭州芯通	77168771	9	2034年8月27日	中國
32.....		杭州芯通	77171241	42	2034年8月27日	中國
33.....	SMARTPACK	杭州芯通	73800779	40	2034年2月20日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	商標	註冊擁有人	註冊編號	類別	屆滿日期	註冊地
34.....	芯通	杭州芯通	73818269	9	2034年4月27日	中國
35.....	芯通半导体	杭州芯通	73816135	40	2034年4月27日	中國
36.....	芯通	杭州芯通	73808147	40	2034年4月27日	中國
37.....	芯通半导体	杭州芯通	73815736	9	2034年4月27日	中國
38.....	Silicon Mitus	SMI	23819459	9	2028年4月13日	中國
39.....	Silicon Mitus	SMI	23819458	42	2028年4月13日	中國
40.....	Silicon Mitus	SMI	5568169	9	2028年9月24日	美國
41.....	Silicon Mitus	SMI	5568170	42	2028年9月24日	美國
42.....	Silicon Mitus	SMI	40-1295825	9	2027年10月19日	韓國
43.....	Silicon Mitus	SMI	40-1267850	42	2027年7月9日	韓國
44.....	실리콘마이터스	SMI	40-1295824	9	2027年10月19日	韓國
45.....	실리콘마이터스	SMI	40-1267849	42	2027年7月9日	韓國
46.....	Silicon Mitus	SMI	40-1295826	9	2027年10月19日	韓國
47.....	Silicon Mitus	SMI	40-1267851	42	2027年7月9日	韓國

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的商標：

序號	商標	註冊擁有人	申請編號	類別	申請日期	註冊地
1.....	Silicon Magic	本公司	7300979	9	2025年10月22日	印度
2.....	Silicon Magic	本公司	7300980	42	2025年10月22日	印度
3.....	Silicon Magic	本公司	2884166	9、42	2025年10月22日	歐盟

附錄七

法定及一般資料

(b) 專利

截至最後實際可行日期，我們為以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的專利的註冊擁有人或有權使用該等專利：

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
1.....	屏蔽柵極溝槽半導體結構與屏蔽柵極溝槽半導體器件	本公司	CN202111170323.1	發明專利	2041年10月7日	中國
2.....	一種超結功率器件及其製造方法	本公司	CN202411247783.3	發明專利	2044年9月5日	中國
3.....	一種電荷泵的過電流保護電路及其控制方法	本公司	CN202410554568.1	發明專利	2044年5月6日	中國
4.....	一種溝槽型MOSFET及製造方法	本公司	CN202310979907.6	發明專利	2043年8月3日	中國
5.....	一種功率半導體器件	本公司	CN202411146981.0	發明專利	2044年8月19日	中國
6.....	一種偏置電路及其偏置電壓控制方法	本公司	CN202410469084.7	發明專利	2044年4月17日	中國
7.....	一種碳化硅溝槽柵MOSFET的元胞結構及版圖	本公司	CN202410381072.9	發明專利	2044年3月28日	中國
8.....	分離柵MOSFET及其製造方法	本公司	CN202111635852.4	發明專利	2041年12月28日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
9.....	一種溝槽型半導體功率器件及版圖	本公司	CN202311468016.0	發明專利	2043年11月5日	中國
10.....	一種溝槽型功率器件及其製備方法	本公司	CN202311586903.8	發明專利	2043年11月23日	中國
11.....	超結器件及其製造方法	本公司	CN202111098970.6	發明專利	2041年9月17日	中國
12.....	柵源結構及製造方法、非對稱溝槽型MOSFET及製造方法	本公司	CN202310428937.8	發明專利	2043年4月17日	中國
13.....	一種溝槽型半導體功率器件及版圖	本公司	CN202310582449.2	發明專利	2043年5月18日	中國
14.....	用於摻雜區的導電通道的製造方法、溝槽型MOSFET器件及其製造方法	本公司	CN202111078843.X	發明專利	2041年9月14日	中國
15.....	一種半導體器件的接觸結構及其製備方法	本公司	CN202211513521.8	發明專利	2042年11月29日	中國
16.....	LDMOS器件結構及其製造方法	本公司	CN202111118014.X	發明專利	2041年9月21日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
17....	一種溝槽型MOSFET的氣隙隔離結構及其製造方法	本公司	CN202310201463.3	發明專利	2043年2月27日	中國
18....	碳化硅MOSFET器件及其製造方法	本公司	CN202110897831.3	發明專利	2041年8月4日	中國
19....	VDMOS器件及其製造方法	本公司	CN202111224609.3	發明專利	2041年10月19日	中國
20....	溝槽柵MOSFET器件的製造方法	本公司	CN202111121658.4	發明專利	2041年9月23日	中國
21....	一種溝槽型MOSFET的氣隙隔離結構及其製造方法	本公司	CN202310200365.8	發明專利	2043年2月27日	中國
22....	一種溝槽型MOSFET的製造方法	本公司	CN202211271251.4	發明專利	2042年10月17日	中國
23....	低導通電阻的超結VDMOS結構	本公司	CN202111584948.2	發明專利	2041年12月22日	中國
24....	提升耐壓工藝窗口的超結器件	本公司	CN202111487782.2	發明專利	2041年12月7日	中國
25....	一種功率半導體器件版圖	本公司	CN202411793170.X	發明專利	2024年12月6日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
26....	一種功率半導體器件版圖	本公司	CN202411793500.5	發明專利	2024年12月6日	中國
27....	一種具有MGD結構的屏蔽柵溝槽器件及其製作方法	本公司	CN202410892640.1	發明專利	2024年7月3日	中國
28....	製造溝槽型MOSFET的方法	本公司	I773605	發明專利	2041年12月2日	台灣
29....	碳化矽MOSFET器件的製造方法	本公司	I785806	發明專利	2041年9月15日	台灣
30....	LDMOS電晶體及其製造方法	本公司	I802048	發明專利	2041年10月17日	台灣
31....	SiC MOSFET器件及其製造方法	本公司	I812995	發明專利	2041年8月10日	台灣
32....	LDMOS晶體管及其製造方法	本公司	I1757035	發明專利	2039年1月13日	美國
33....	碳化矽MOSFET器件及其製造方法	本公司	I1894440	發明專利	2041年9月19日	美國
34....	LDMOS晶體管及其製造方法	本公司	I2279442	發明專利	2041年10月21日	美國
35....	溝槽型MOSFET及其製造方法	本公司	I2176432	發明專利	2041年6月11日	美國
36....	採用負電感電流跟蹤控制提高同步開關變換器效率(네거티브 전류 트래킹 제어 기능이 구비된 스위칭 컨버터)	SMI	10-2733873	不適用	2043年4月6日	韓國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
37....	時鐘數據恢復裝置 (클럭 데이터 복원 장치)	SMI	10-2733873	不適用	2042年8月25日	韓國
38....	一種具備飛跨電容電壓均衡電路的三電平降壓或升壓轉換器 (플라잉 커패시터 전압 밸런싱 회로를 포함하는 3 레벨 컨버터)	SMI	10-2642713	不適用	2042年6月6日	韓國
39....	一種具備飛跨電容電壓均衡電路的三電平降壓升壓轉換器 플라잉 커패시터 전압 밸런싱 회로를 포함하는 3 레벨 벡-부스트 컨버터	SMI	10-2626361	不適用	2042年5月17日	韓國
40....	開關電容轉換器 (스위치 커패시터 컨버터)	SMI	10-2678371	不適用	2041年12月16日	韓國
41....	具有電池單元均衡功能的電源轉換電路 (배터리 셀 밸런싱 기능을 포함하는 전력 변환 회로)	SMI	10-2528454	不適用	2041年1月5日	韓國
42....	電源電路 (전원 공급 회로)	SMI	10-2382987	不適用	2040年11月11日	韓國
43....	具有可變電壓轉換比的開關電容轉換器 (가변 전압 변환비를 갖는 스위치드 커패시터 컨버터)	SMI	10-2439280	不適用	2040年11月1日	韓國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
44.....	基於庫侖計的電池電量狀態估算裝置及方法 (쿨롱 카운터 기반의 배터리 충전상태 추정장치 및 방법)	SMI	10-2382988	不適用	2040年5月10日	韓國
45.....	開關電容轉換器 (스위치 커패시터 컨버터)	SMI	10-2355293	不適用	2039年9月26日	韓國
46.....	多節電池單元可串並聯切換的電力管理裝置 (복수의 배터리 셀의 직렬, 병렬 전환이 가능한 전력관리장치)	SMI	10-2196926	不適用	2039年7月9日	韓國
47.....	適用於多節串聯電池的電力管理裝置 (복수의 셀이 직렬 연결된 배터리에 사용가능한 전력관리장치)	SMI	10-2236017	不適用	2039年6月9日	韓國
48.....	動態電流檢測轉換器 (동적으로 전류를 센싱하는 컨버터)	SMI	10-1979622	不適用	2037年7月12日	韓國
49.....	升降壓轉換器及其控制方法	SMI	US9,973,090B1	不適用	2036年10月19日	美國
50.....	柵極驅動電路和柵極時鐘生成電路 (게이트구동회로 및 게이트클럭생성회로)	SMI	10-1869421	不適用	2036年10月5日	韓國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	專利號	專利類別	屆滿日期	註冊地
51.....	單電感多輸出轉換器 (싱글인덕터 멀티아웃풋 컨버터)	SMI	10-1869408	不適用	2035年7月3日	韓國
52.....	電池餘量測定裝置及方法 (배터리잔량 측정 장치 및 방법)	SMI	10-1653967	不適用	2034年9月22日	韓國
53.....	LED發光裝置及其驅動方法	SMI	US8,525,433B2	不適用	2030年6月28日	美國
54.....	電平移器及包含該裝置的驅動電路	SMI	US7,893,730B2	不適用	2030年2月3日	美國

截至最後實際可行日期，我們已申請以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的專利：

序號	專利	專利權人	申請編號	專利類別	申請日期	註冊地
1.....	一種功率半導體器件版圖	本公司	CN202411793170.X	發明專利	2024年12月6日	中國
2.....	一種功率半導體器件版圖	本公司	CN202411793500.5	發明專利	2024年12月6日	中國
3.....	一種功率開關器件	本公司	CN202411269299.0	發明專利	2024年9月10日	中國
4.....	一種功率開關器件	本公司	CN202411266088.1	發明專利	2024年9月10日	中國
5.....	一種具有MGD結構的屏蔽柵溝槽器件及其製作方法	本公司	CN202410892640.1	發明專利	2024年7月3日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	專利	專利權人	申請編號	專利類別	申請日期	註冊地
6.....	一種半導體溝槽結構的製造方法	本公司	CN202311703375.X	發明專利	2023年12月12日	中國
7.....	高速低功耗DDI驅動	本公司	2025102790099	發明專利	2025年3月10日	中國
8.....	半導體器件及其製造方法	本公司	202510510200X	發明專利	2025年4月22日	中國
9.....	溝槽型MOSFET的製造方法	本公司	US18/299245	發明專利	2023年4月12日	美國
10.....	超結器件	本公司	US18/176547	發明專利	2023年3月1日	美國
11.....	超結器件及其製造方法	本公司	US17/946100	發明專利	2022年9月16日	美國
12.....	分離柵功率MOS器件及其製造方法	本公司	US17/887573	發明專利	2022年8月15日	美國
13.....	碳化硅MOSFET器件及其製造方法	本公司	US17/881736	發明專利	2022年8月5日	美國
14.....	溝槽柵半導體器件及其製造方法	本公司	18946945	發明專利	2024年11月14日	美國
15.....	溝槽柵半導體器件	本公司	19033515	發明專利	2025年1月22日	美國

附錄七

法定及一般資料

(c) 集成電路布圖設計

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對我們業務屬重大或可能屬重大的集成電路布圖設計：

序號	電路設計名稱	註冊擁有人	註冊編號	申請日期	註冊地
1....	Enhancement Planar MOS_X43	本公司	BS.215598482	2021年8月12日	中國
2....	Enhancement Planar MOS_W14	本公司	BS.215598520	2021年8月12日	中國
3....	Enhancement Planar MOS_X45	本公司	BS.215598962	2021年8月13日	中國
4....	Enhancement Planar MOS_X51	本公司	BS.215598989	2021年8月13日	中國
5....	Enhancement Planar MOS_W18	本公司	BS.215598709	2021年8月13日	中國
6....	Enhancement Planar MOS_W19	本公司	BS.215598938	2021年8月13日	中國
7....	Enhancement Planar MOS_W12	本公司	BS.215598954	2021年8月13日	中國
8....	Enhancement Planar MOS_W16	本公司	BS.215598539	2021年8月12日	中國
9....	Enhancement SGT MOS_M15G08A	本公司	BS.235524182	2023年4月13日	中國
10....	Enhancement SGT MOS_MG36A	本公司	BS.235524220	2023年4月13日	中國
11....	Enhancement SGT MOS_F06A65AN	本公司	BS.235524352	2023年4月13日	中國
12....	Enhancement SGT MOS_MA04A61AN	本公司	BS.235524212	2023年4月14日	中國
13....	SM5810	本公司	BS.235553603	2023年7月7日	中國
14....	SM5820	本公司	BS.23555362X	2023年7月7日	中國
15....	SM5840	本公司	BS.235553638	2023年7月7日	中國
16....	SM4821	本公司	BS.235558907	2023年7月25日	中國
17....	SM5603	本公司	BS.235553530	2023年7月7日	中國
18....	SM4813	本公司	BS.235553387	2023年7月7日	中國
19....	SM4812	本公司	BS.235553352	2023年7月7日	中國
20....	SM8101	本公司	BS.235554391	2023年7月11日	中國
21....	SM4808	本公司	BS.235553123	2023年7月6日	中國
22....	SM4809	本公司	BS.23555331X	2023年7月7日	中國
23....	Enhancement SJ MOS_LG06	本公司	BS.235566160	2023年8月15日	中國
24....	Enhancement SJ MOS_SJ03A	本公司	BS.235566179	2023年8月15日	中國

附錄七

法定及一般資料

序號	電路設計名稱	註冊擁有人	註冊編號	申請日期	註冊地
25...	Enhancement SiC MOS_XAA2C03AB	本公司	BS.235566195	2023年8月15日	中國
26...	SiC_MPS_ECPZA01_1200V	本公司	BS.235566187	2023年8月15日	中國
27...	SiC_MPS_ECPZA01_650V	本公司	BS.235566152	2023年8月15日	中國
28...	SM4820	本公司	BS.235558893	2023年7月25日	中國
29...	1200V_SiC_Mosfet (XAA2A09AB)	本公司	BS.245566759	2024年8月29日	中國
30...	30V_SGT (F03A89AN)	本公司	BS.24556666X	2024年8月29日	中國
31...	60V_SGT (F06A94AN)	本公司	BS.245566708	2024年8月29日	中國
32...	100V_SGT (F10A78AN)	本公司	BS.245566716	2024年8月29日	中國
33...	40V_SGT (F04A88AN)	本公司	BS.245566678	2024年8月29日	中國
34...	SM5328BF	本公司	BS.245567348	2024年9月2日	中國
35...	SM4852_BB	本公司	BS.245567291	2024年9月2日	中國
36...	SM4852_CTL	本公司	BS.245567313	2024年9月2日	中國
37...	SM5112	本公司	BS.24556733X	2024年9月2日	中國
38...	SM5109CF	本公司	BS.245567321	2024年9月2日	中國

(d) 域名

截至最後實際可行日期，我們已註冊以下我們認為對本集團業務屬重大或可能屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.....	silicon-magic.com	本公司	2020年8月17日	2026年8月17日
2.....	silicon-top.com	杭州芯通	2023年8月8日	2026年8月8日
3.....	siliconmitus.com	SMI	2007年2月14日	2030年2月14日

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，概無其他對我們業務屬重大的商標或服務商標、專利、知識產權或工業產權。

C. 有關我們董事及主要股東的進一步資料

1. 董事及主要行政人員

(i) 我們董事及主要行政人員的權益披露

緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使及自最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動），我們各董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有的須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會我們及聯交所的權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》有關條文被視為或當作擁有的權益及淡倉）或須根據《證券及期貨條例》第352條記錄於該條所述登記冊內的權益及淡倉或須根據《上市規則》附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會我們及聯交所的權益及淡倉如下：

於本公司的權益

姓名	職位	權益性質	[編纂]後將持有的股份數目及類別	緊隨[編纂]完成後於[編纂]股份/H股（如適用）中的概約股權百分比 ⁽⁴⁾
任博士	董事長、執行董事兼首席執行官	受控法團權益 ⁽²⁾	[編纂]股 （[編纂]股份）（L）	[編纂]%
			[編纂]股 （H股）	[編纂]%
		與其他人士共同持有之權益 ⁽³⁾	[編纂]股 （[編纂]股份）（L）	[編纂]%
			[編纂]股 （H股）（L）	[編纂]%

附錄七

法定及一般資料

姓名	職位	權益性質	[編纂]後 將持有的 股份數目及類別	緊隨[編纂] 完成後於 [編纂]股份/ H股(如適用) 中的概約 股權百分比 ⁽⁴⁾
Huh博士	副董事長兼 執行董事	實益擁有人	[編纂]股 ([編纂]股份)(L)	[編纂]%
			[編纂]股 (H股)(L)	[編纂]%
		受控法團權益 ⁽⁴⁾	[編纂]股 ([編纂]股份)(L)	[編纂]%
			[編纂]股 (H股)(L)	[編纂]%
謝力先生	非執行董事	受控法團權益 ⁽⁵⁾	[編纂]股 (H股)(L)	[編纂]%

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於我們股份的好倉。
- (2) 截至最後實際可行日期，杭州親芯為杭州模芯的普通合夥人，而任博士持有杭州親芯80%的股權。因此，就《證券及期貨條例》而言，杭州親芯及任博士各自被視為於杭州模芯直接持有的股份中擁有權益。
- (3) 根據日期為2025年6月19日的一致行動協議，杭州模芯、智益、智富、杭州親芯、Bright Shine、任博士及蘇博士為有關本公司股東大會決策的一致行動人士，該一致行動將於[編纂]後繼續有效。因此，根據《證券及期貨條例》，上述各方均被視為於其他各方擁有權益的股份中擁有權益。
- (4) 截至最後實際可行日期，Huh博士作為唯一有限合夥人持有智益99.99997%的權益。因此，就《證券及期貨條例》而言，Huh博士被視為於智益直接持有的股份中擁有權益。
- (5) 截至最後實際可行日期，浙江海邦私募基金管理有限公司（「海邦管理」）為杭州海邦啟悅股權投資合夥企業（有限合夥）（「海邦啟悅」）、杭州海邦睿柏股權投資合夥企業（有限合夥）（「海邦睿柏」）及龍游海邦新智創業投資合夥企業（有限合夥）（「龍游海邦新智」）的普通合夥人。此外，寧波海邦星材創業投資合夥企業（有限合夥）（「寧波海邦」）的普通合夥人為杭州海邦豐華投資管理有限公司，後者由海邦管理全資擁有。海邦管理由杭州立晟投資管理有限公司持有50%的股權，而後者由謝力先生持有80%的股權。因此，就《證券及期貨條例》而言，謝力先生被視為於海邦啟悅、海邦睿柏、龍游海邦新智及寧波海邦所持股份中擁有權益。

截至最後實際可行日期，概無董事或其各自配偶及18歲以下子女獲本公司授予或已行使任何認購本公司或其任何相聯法團股份或債權證的權利。

(ii) 服務協議及委任書詳情

本公司[已與各董事訂立]服務協議或委任書，當中載有與遵守相關法律法規及遵守組織章程細則等有關的條文。

該等服務協議及委任書的主要詳情為：(a)各服務協議或委任書的任期為自其獲委任日期起計三年；及(b)各服務協議或委任書可根據其各自條款予以終止。服務協議及委任書可根據組織章程細則及適用規則予以續期。

除上文所披露者外，概無董事已經或擬與本集團任何成員公司訂立服務合同（於一年內屆滿或可由有關僱主於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）的合同除外）。

(iii) 董事薪酬

有關往績記錄期間的所有董事薪酬詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註44。

於往績記錄期間，我們並無支付且董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為加入本公司的激勵或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們並無支付且董事、前任董事或五名最高薪酬人士亦無收取任何薪酬，作為離任有關管理本公司任何附屬公司事務的職務的補償。

於往績記錄期間，概無董事已放棄任何薪酬。除上文所披露者外，於往績記錄期間，我們或我們的任何附屬公司概無其他已付或應付董事或五名最高薪酬人士的款項。

2. 主要股東

於本公司股份的權益

除本文件「主要股東」一節所披露者外，董事並不知悉將有任何其他人士於緊隨[編纂]完成後於本公司股份或相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV

部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉或直接或間接於附帶權利可在任何情況下於本公司股東大會上投票的任何類別股本面值的10%或以上中擁有權益。

3. 免責聲明

除本文件所披露者外：

- (i) 概無董事或本公司主要行政人員於本公司或任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》第XV部）的股份、相關股份及債權證中擁有任何一旦本公司H股[編纂]將須根據《證券及期貨條例》第XV部第7及8分部知會我們及聯交所的權益及淡倉（包括根據《證券及期貨條例》條文其被當作或視作擁有的權益及淡倉）或須根據《證券及期貨條例》第352條記錄於該條所述登記冊內的權益及淡倉或須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則知會我們及聯交所的權益及淡倉；
- (ii) 就任何董事或本公司主要行政人員所知，概無其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）將於緊隨[編纂]完成後於我們股份及相關股份中擁有根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部的條文須向本公司及聯交所披露的權益或淡倉或（並非本集團成員）將直接或間接於附帶權利可在任何情況下於本集團任何成員公司股東大會上投票的任何類別股本面值的10%或以上中擁有權益；
- (iii) 除本文件「[編纂]」一節所披露者外，於截至本文件日期止兩個年度內，概無就發行或出售本公司任何股份或債權證而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款；
- (iv) 本附錄「專家資格」一段所列各方概無(i)於本公司任何股份或其任何附屬公司任何股份中擁有法定或實益權益；或(ii)擁有任何權利（不論是否可依法強制執行）認購或提名他人認購本公司證券；
- (v) 概無董事或本附錄「專家資格」一段所列任何專家於本文件日期仍然存續且對本集團整體業務而言屬重大的任何合同或安排中擁有重大權益；

- (vi) 概無董事、其緊密聯繫人或本公司任何股東(據董事所知擁有本公司已發行股本5%以上)於往績記錄期間各年度／期間的本集團五大供應商或五大客戶中擁有任何權益；及
- (vii) 概無董事為擁有本公司股本權益的公司的董事或僱員，一旦H股於香港聯交所[編纂]，有關權益將須根據《證券及期貨條例》第XV部第2及3分部予以披露。

D. [編纂]僱員股份激勵計劃

以下為[編纂]僱員股份激勵計劃的主要條款概要。由於[編纂]僱員股份激勵計劃的條款並不涉及本公司於[編纂]後授出購股權或獎勵，因此不受《上市規則》第十七章條文的規限。鑒於截至最後實際可行日期，[編纂]僱員股份激勵計劃項下於僱員股份激勵計劃平台的合夥權益所附有的相關股份(「虛擬股份」)已發行予僱員股份激勵計劃平台，[編纂]僱員股份激勵計劃的運作將不會對已發行股份產生任何攤薄效應。

(a) 目的

[編纂]僱員股份激勵計劃的目的是激勵本集團董事、高級管理層及僱員為本集團提供更優質的服務。目標是使僱員努力與本公司增長保持一致，並最終實現股份的成功首次[編纂]。

(b) 合資格參與者

[編纂]僱員股份激勵計劃的合資格參與者應為本集團的僱員。

(c) 管理

[編纂]僱員股份激勵計劃應由我們董事會管理，董事會可將管理職能委託予本公司總經理。

(d) 購股權授出

根據[編纂]僱員股份激勵計劃，我們董事會可向僱員(「承授人」)授出購買虛擬股份的購股權(「授出」)。

(e) 授出條款

承授人須通過與本公司以及相關僱員股份激勵計劃平台及其普通合夥人等訂立股權激勵協議（「**激勵協議**」）接受授出，該協議載明授出的條款及條件，概述如下：

- 期限 — 承授人有權於授出日期至本公司改制為股份有限公司日期期間的任何時間及以任何次數即時行使購股權，惟須遵守激勵協議所述的任何提前終止條款（「**期限**」）。
- 行使價 — 每股虛擬股份購股權的行使價（「**行使價**」）應由我們董事會全權酌情決定並載於激勵協議內。
- 行使程序 — 承授人可於期限內通過向本公司遞交指定行使申請表格連同其就行使購股權相對應的虛擬股份數目應付的行使價總額款項行使獲授購股權。經本公司、僱員股份激勵計劃平台及其普通合夥人接納後，承授人將須簽署相關僱員股份激勵計劃平台的合夥協議並成為相關僱員股份激勵計劃平台的有限合夥人。
- 虛擬股份轉讓 — 承授人轉讓虛擬股份須經相關僱員股份激勵計劃平台普通合夥人同意並受激勵協議所載限制約束。倘相關僱員股份激勵計劃平台的普通合夥人同意承授人擬轉讓其持有的虛擬股份，承授人須轉讓其擁有的全部虛擬股份並退出僱員股份激勵計劃平台，除非激勵協議另有規定或相關僱員股份激勵計劃平台的普通合夥人書面批准。
- 僱員股份激勵計劃平台贖回 — 於發生激勵協議所載任何觸發事件（包括但不限於(i)承授人嚴重違反激勵協議；(ii)承授人嚴重違反其於與本集團任何協議項下的職責；(iii)嚴重違反適用於本集團及／或承授人的法律法規；(iv)終止與本集團的僱傭關係；或(v)承授人死亡）時，相關僱員股份激勵計劃平台普通合夥人可按激勵協議預定價格以其可指示的方式贖回或另行要求承授人轉讓其全部虛擬股份。

附錄七

法定及一般資料

- 權益變現 — 在遵守我們董事會可能釐定並載於激勵協議的歸屬條件及限售安排的情況下，承授人有權要求相關僱員股份激勵計劃平台按市價贖回其已歸屬部分的虛擬股份。
- 承授人權利 — 承授人僅有權享有相關僱員股份激勵計劃平台持有的與其擁有的虛擬股份相對應的有關數目相關股份的經濟利益，而非其他權利，包括但不限於相關股份所附投票權。

(h) 相關股份數目

僱員股份激勵計劃平台目前為[編纂]僱員股份激勵計劃持有6,646,974股股份（待[編纂]完成後，將[編纂]為[編纂]股股份），佔本公司於緊隨[編纂]完成後已發行股本的約[編纂]%（不計及因[編纂]獲行使而可能發行的股份）。

(i) 股本變動的影響

如本公司股本因任何原因發生變動，向承授人授出的虛擬股份數目將保持不變，但承授人通過僱員股份激勵計劃平台間接擁有權益的相關股份數目將按比例調整。

(j) 進一步資料

截至最後實際可行日期，僱員股份激勵計劃平台為[編纂]僱員股份激勵計劃而持有的全部相關股份（即6,646,974股股份）已獲分配至相應虛擬股份並授予403名承授人。

下表載列根據[編纂]僱員股份激勵計劃向我們董事及高級管理層成員授出的相關股份（分配為虛擬股份）詳情：

承授人姓名	於本集團的職位	虛擬 股份數目	相關股份數目 (就[編纂] 作出調整)	[編纂] 完成後 佔本公司 已發行股本 百分比 ⁽¹⁾
任博士	董事長、執行董事 兼首席執行官	8,111,855	[編纂]	[編纂]%

附錄七

法定及一般資料

承授人姓名	於本集團的職位	虛擬 股份數目	相關股份數目 (就[編纂] 作出調整)	[編纂] 完成後 佔本公司 已發行股本 百分比 ⁽¹⁾
Huh博士	副董事長、執行董事 兼SMI行政總裁	5,000,000	[編纂]	[編纂]%
孫君萍	監事	12,500	[編纂]	[編纂]%
蘇博士	行政事務執行副總裁 兼聯席公司秘書	853,641	[編纂]	[編纂]%
梁建雄	銷售副總裁	800,000	[編纂]	[編纂]%
李曉蕾	財務總監	150,000	[編纂]	[編纂]%
Kim Jong Hwan	SMI工程部高級副總裁	342,587	[編纂]	[編纂]%
其餘396名承授人 . . .	-	13,529,417	[編纂]	[編纂]%

附註：

(1) 不計及因[編纂]獲行使而可能發行的任何股份。

鑒於全部虛擬股份已獲授出且全部相關股份已分配予承授人，[編纂]僱員股份激勵計劃項下將不會作出進一步授出。

E. 其他資料

1. 遺產稅

我們董事獲告知，根據中國法律，本公司或我們任何附屬公司不太可能承擔重大遺產稅責任。

2. 訴訟

截至最後實際可行日期，我們並不知悉任何針對本集團任何成員公司的重大待決或面臨威脅的訴訟、仲裁或申索，而該等訴訟、仲裁或申索可能對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。

3. 獨家保薦人

獨家保薦人符合《上市規則》第3A.07條所載的適用於保薦人的獨立性標準。

獨家保薦人將獲本公司支付500,000美元的費用，以就[編纂]擔任本公司的獨家保薦人。

4. 合規顧問

本公司已根據《上市規則》第3A.19條委任華富建業企業融資有限公司為其合規顧問。

5. 開辦費用

我們並無就本公司註冊成立而產生任何重大開辦費用。

6. H股持有人稅務

H股的出售、購買及轉讓如在本公司H股股東名冊上進行(包括在聯交所進行有關交易的情況)，則須繳納香港印花稅。有關出售、購買及轉讓的現行香港印花稅稅率為所出售或轉讓H股的對價或公允價值的0.1%(以較高者為準)。

7. 專家資格

以下為提供本文件所載意見或建議的專家(定義見《上市規則》及《公司(清盤及雜項條文)條例》)的資格：

名稱	資格
華泰金融控股(香港)有限公司	進行第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)、第3類(槓桿式外匯交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)、第7類(提供自動化交易服務)及第9類(資產管理)受規管活動的持牌法團(定義見《證券及期貨條例》)
嘉源律師事務所	有關中國法律的法律顧問
法務法人(有限)太平洋	有關韓國法律的法律顧問
Stephen Peepels, Esq.	有關出口管制與制裁法律的法律顧問
羅兵咸永道會計師事務所	《專業會計師條例》(香港法例第50章)項下的執業會計師及《會計及財務匯報局條例》(香港法例第588章)項下的註冊公眾利益實體核數師
弗若斯特沙利文	獨立行業顧問
立信稅務師事務所(浙江)有限公司	中國大陸地區的轉讓定價顧問
律村律師事務所	韓國地區的轉讓定價顧問

8. 專家同意書

名列上述第7段的各專家[已就刊發本文件發出書面同意書，表示同意按本文件所載的形式及內容轉載其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及提述其名稱，且並無]撤回其同意書。

截至最後實際可行日期，上述專家概無於本公司或我們任何附屬公司擁有任何股權或擁有認購或提名他人認購本集團任何成員公司證券的權利（不論是否可依法強制執行）。

9. 發起人

本公司的發起人為：

- (1) 瓦森納科技香港有限公司；
- (2) 杭州喜達芯企業管理合夥企業（有限合夥）；
- (3) 杭州喜杭芯企業管理合夥企業（有限合夥）；
- (4) 杭州模芯；
- (5) 智富；
- (6) 智益；
- (7) 杭州海邦啟悅股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (8) 智晶國際投資有限公司；
- (9) 珠海巍恒股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (10) HSG Growth VI Holdco B (HK) Limited；
- (11) 北京君聯晟源股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (12) 珠海君聯星澤股權投資企業（有限合夥）；
- (13) 海風投資有限公司；
- (14) 杭州芯盛微股權投資合夥企業（有限合夥）；

- (15) 合肥華芯科瑞集成電路投資合夥企業（有限合夥）；
- (16) 合肥華登二期集成電路產業投資合夥企業（有限合夥）；
- (17) Cosmic Warrior (HK) Limited；
- (18) 湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）；
- (19) 寧德時代新能源科技股份有限公司；
- (20) Huh博士；
- (21) 國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司；
- (22) 杭州芯成微股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (23) 杭州芯宇微股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (24) 廣州廣祺欣邁管理諮詢合夥企業（有限合夥）；
- (25) 珠海市紅土湛盧股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (26) 嘉興恒隼邦股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (27) 杭州富陽項恒股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (28) 蘇州華業致遠三號股權投資合夥企業（有限合夥）；
- (29) 嘉興泰芯科啟創業投資合夥企業（有限合夥）；
- (30) 杭州星成聯芯創業投資合夥企業（有限合夥）；

- (31) 杭州寓鑫創業投資合夥企業(有限合夥)；
- (32) 宜賓綠能股權投資合夥企業(有限合夥)；
- (33) 廣東長拓石創業投資合夥企業(有限合夥)；
- (34) 杭州芯嵐微創業投資合夥企業(有限合夥)；
- (35) 珠海君聯星馳創業投資企業(有限合夥)；
- (36) 杭州華芯雲邁股權投資合夥企業(有限合夥)；
- (37) 宜賓晨道新能源產業股權投資合夥企業(有限合夥)；
- (38) 浙江金控投資有限公司(現稱為浙江省創新資本投資有限公司)；
- (39) 杭州海邦睿柏股權投資合夥企業(有限合夥)；
- (40) 寧波海邦星材創業投資合夥企業(有限合夥)；及
- (41) 青島精確芯陽科技中心(有限合夥)。

於緊接本文件日期前兩年內，概無就[編纂]或本文件所述相關交易向上述發起人支付、分配或給予或擬支付、分配或給予現金、證券或其他利益。

10. 雙語文件

本文件將分別以英文版本及中文版本刊發。

11. 約束力

倘根據本文件提出申請，本文件即具效力，在適用情況下使所有有關人士受《公司（清盤及雜項條文）條例》第44A及44B條所有條文（罰則除外）約束。

12. 無重大不利變動

我們董事確認，本集團業務運營及財務狀況或前景自2025年9月30日（即本集團最新經審計合併財務報表的編製日期）以來並無重大不利變動。

13. 雜項

(a) 除本文件所披露者外，於緊接本文件日期前兩年內：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司概無發行或同意發行或擬發行任何股份或借貸資本或債權證以換取現金或任何以現金以外的對價繳足或部分繳足的股份或借貸資本或債權證；及
- (ii) 概無就發行或出售本公司或我們任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出或同意授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款。

(b) 除本文件所披露者外：

- (i) 本公司或我們任何附屬公司概無創始人股份、管理層股份或遞延股份或任何債權證；
- (ii) 概無放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (iii) 我們概無訂立期限超過一年且對我們業務而言屬重大的計劃租用或租購合同；
- (iv) 本公司或我們任何附屬公司的股份或借貸資本或債權證概無附有或有條件或無條件同意附有購股權；

- (v) 本公司概無就發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出佣金、折扣、經紀佣金或其他特別條款，以認購或同意認購或促使或同意促使認購本公司或我們任何附屬公司的任何股份或債權證；
 - (vi) 除就[編纂]將予發行的H股外，我們的股本及債務證券概無在任何其他證券交易所[編纂]或[編纂]，亦無尋求或擬尋求任何[編纂]或[編纂]批准；及
 - (vii) 本公司或我們任何附屬公司概無發行在外的債權證或可換股債務證券。
- (c) 除本文件所披露者外，我們董事或專家（如本文件所載）概無於緊接本文件日期前兩年內於本集團任何成員公司已收購或出售或承租或本集團任何成員公司擬收購或出售或承租的任何資產中擁有任何直接或間接權益。
- (d) 於本文件日期前12個月內，本集團業務概無發生任何可能對或已對本集團財務狀況產生重大影響的中斷。